

90/526800

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРом О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)
 Наш № РСТ/RU03/00410 от 25 сентября 2003 (25.09.2003) от ПОЛУЧАЮЩЕГО ВЕДОМСТВА
 ИСХ 91570125С9С3

REGD PCT 07 MAR 2005

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НОМЕРЕ
 МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ И
 ДАТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДАЧИ**

(Правило 20.5 (с) Инструкции к РСТ)

Кому:

603950, г. Нижний Новгород,
 ул. Ульянова, 46,
 Институт прикладной физики РАН,
 патентная группа,
 О. В. Бабиной

№ дела заявителя: -		Является важным уведомлением	
Номер международной заявки: РСТ/RU 03/00410	Дата международной подачи: 18 сентября 2003 (18.09.2003)	Дата приоритета: 30 сентября 2002 (30.09.2002)	
Заявитель: Институт прикладной физики РАН и др.			
Название изобретения: Высокоскоростной способ осаждения алмазных пленок из газовой фазы в плазме СВЧ разряда и плазменный реактор для его реализации			

1. Настоящим заявитель уведомляется о том, что вышеуказанной международной заявке присвоены номер и дата подачи, представленные выше.

2. Далее заявитель уведомляется, что регистрационный экземпляр международной заявки:

☒ направлен в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

☐ еще не направлен в Международное бюро ВОИС по причинам, указанным ниже, причем копия настоящего уведомления отправлена Международному бюро *:

☐ поскольку не получено требуемое разрешение по мотивам национальной безопасности.

☐ поскольку (указать причину):

*) Международное бюро отслеживает пересылку Получающим ведомством регистрационного экземпляра и уведомляет заявителя (по форме РСТ /В/ 301) о его получении. Если регистрационный экземпляр не будет получен к истечению 14 месяцев с даты приоритета, Международное бюро уведомит заявителя об этом (Правило 22.1 (с)).

Наименование и адрес получающего ведомства:
 Федеральный институт промышленной собственности,
 Бережковская наб., 30-1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995, Россия,
 тел.(095) 240-58-88, факс (095) 243-33-37
 телетайп 114818 ПОДАЧА

Подпись уполномоченного лица:



Т.В.Апарина

CORRESPONDENCE UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY
from the receiving office
Our Ref. 9157 dated 25 September 2003

PCT

Notice about the number of international application and the date of international filing
(Rule 20.5(c) of the PCT Instruction)

To: O.V. Babina, Patent Group,
Institute of Applied Physics, 46 Ulyanov Street, 603950 Nizhny Novgorod, Russia

No. of the Applicant's File: —

Important notice!

Number of international application: PCT/RU 03/00410
Date of international application: 18 September 2003 (18.09.2003)
Priority date: 30 September 2002 (30.09.2002)

Applicant: Institute of Applied Physics RAS, et al.

Title of invention: *High velocity method for depositing diamond films from a gaseous phase in SHF discharge plasma and a plasma reactor for carrying out said method.*

1. This is to notify the applicant that the aforesaid international application has been assigned the number and date of filing shown above.
2. The applicant is further notified that the registration copy of the international filing:
 - (X) has been sent to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.
 - has not been sent to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization due to the reasons stated below, and a copy of this notice has been sent to the International Bureau*:
 - o because the required permit has not been obtained due to national security reasons.
 - o because (state the reason).

* The International Bureau traces sending of the registration copy by the Receiving office and notifies the Applicant about receiving the said copy using Form PCT /IB/ 301. Should the registration copy fail to be received at the end of 14 months since the priority date, the International Bureau shall notify the Applicant about that (Rule 22.1 (c)).

Title and address of the Receiving office:
Federal Institute of Industrial Property,
30-1 Berezhkovskaya Naberezhnaya, Moscow, GSP-5, 123995 Russia
phone (095) 240-58-88, fax (095) 243-33-37
Teletype 114818 ПОДАЧА

Authorized signature: (signed by)
T.V. Aparina